

2SC2240 (3DG2240)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途：用于低噪声音频放大。

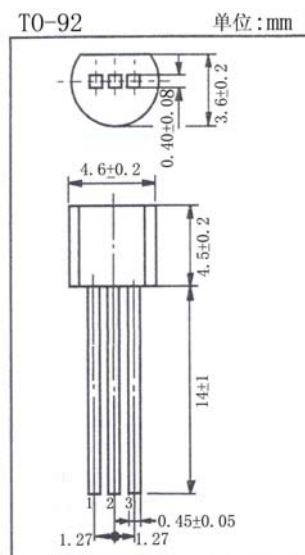
Purpose: Low noise audio amplifier applications.

特征：低噪声, 高直流电流增益, 高击穿电压。

Features: Low noise, high DC current gain, high breakdown voltage.

极限参数/Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CBO}	120	V
V_{CEO}	120	V
V_{EBO}	5.0	V
I_C	100	mA
I_E	-100	mA
P_C	300	mW
T_j	150	°C
T_{stg}	-55~150	°C



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CEO}	$I_C=1.0\text{mA}$	$I_B=0$	120			V
I_{CBO}	$V_{CB}=120\text{V}$	$I_E=0$			0.1	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=5.0\text{V}$	$I_C=0$			0.1	μA
h_{FE}	$V_{CE}=6.0\text{V}$	$I_C=2.0\text{mA}$	200		700	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}$	$I_B=1.0\text{mA}$			0.3	V
V_{BE}	$V_{CE}=6.0\text{V}$	$I_C=2.0\text{mA}$		0.65		V
f_T	$V_{CE}=6.0\text{V}$	$I_C=1.0\text{mA}$		100		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$	$I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		3.0		pF
NF	$V_{CE}=6.0\text{V}$ $I_C=0.1\text{mA}$ $f=10\text{Hz}$ $R_g=10\text{K}\Omega$				6.0	dB
	$V_{CE}=6.0\text{V}$ $I_C=0.1\text{mA}$ $f=1\text{KHz}$ $R_g=10\text{K}\Omega$				2.0	
	$V_{CE}=6.0\text{V}$ $I_C=0.1\text{mA}$ $f=1\text{KHz}$ $R_g=100\Omega$			4.0		

h_{FE} 分档/ h_{FE} classifications: GR:200~400 BL:350~700

2SC2240 (3DG2240)

